

# 日程表 (会場別1)

会場名	収容人数	9月19日(火)		9月20日(水)		9月21日(木)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	
熊本城ホール	A201	298	09:00 ~ 12:30 12.4 有機EL・トランジスタ	14:00 ~ 17:45 T5 光で拓く「キラル物質科学」の最前線	09:00 ~ 12:00 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	13:30 ~ 18:00 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15)	09:20 ~ 11:50 NT2【一般公開】就活生必見！業界はあなたを求めている！～成長する半導体産業を未来へつなぐ多様な人財	13:30 ~ 16:55 T19 日本が挑む最先端ロジックへの再挑戦
	A202	160	09:00 ~ 11:30 17.3 層状物質	13:00 ~ 14:45 8.3 プラズマナノテクノロジー 16:00 ~ 18:00 17.3 層状物質	09:30 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:00 ~ 17:00 T18 界面ナノ電子化学：深化する半導体ウエットプロセス	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:50 T21 光と物質の相互作用が創り出す二次元材料研究の新しい潮流
	A301	240	09:00 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	14:00 ~ 16:45 T16 酸化物半導体が拓く太陽電池の新展開	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:00 ~ 18:45 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス	09:00 ~ 11:35 T12 量子技術の最前線と社会実装の潮流	13:30 ~ 17:10 T12 量子技術の最前線と社会実装の潮流
	A302	240	09:00 ~ 11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 17:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:45 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	13:00 ~ 17:00 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:00 ~ 15:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 16:00 ~ 17:00 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 17:00 ~ 17:45 8.6 Plasma Electronics English Session
	A303	240	09:00 ~ 11:30 チュートリアル(一杉 太郎 (東京大学))	14:00 ~ 16:30 チュートリアル(松本 要(九州工業大学名誉教授))	09:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:30 ~ 19:00 T17 先端のサイバーフィジカルシステム：半導体モノづくりをAI・最適化計算で加速できるか？	09:00 ~ 12:05 T14 クロスオーバーシンポジウム「有機エレクトロニクスの開拓と未来展望」	13:30 ~ 18:05 T14 クロスオーバーシンポジウム「有機エレクトロニクスの開拓と未来展望」
	A304	240	09:00 ~ 12:00 半導体セミナー(柴田 直 (東京大学名誉教授))		09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:00 ~ 17:00 T8 イオンロニクスにおける酸化物・カルコゲナートの新機能	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:55 T9 薄膜・表面物理における研究手法技術の最新動向
	A305	71		13:30 ~ 16:15 T1 科学教育の人材育成および教育の取り組みとその活性化～南九州地区～	09:00 ~ 11:30 3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	13:00 ~ 19:30 3.3 生体・医用光学 (旧3.4)	09:00 ~ 11:45 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:30 ~ 18:25 T6 日韓共同応用物理シンポジウム「フォトニクス技術」
	A306	144	10:00 ~ 11:30 授賞式 (フェロ-表彰式、名誉会員・功労会員証贈呈式、講演奨励賞授賞式)	13:00 ~ 17:30 2.1 検出器デバイス開発	09:15 ~ 11:30 17.2 グラフェン	13:00 ~ 16:15 17.2 グラフェン	09:00 ~ 11:30 17.2 グラフェン	
	A307	118	09:00 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:30 ~ 17:30 NT3【一般公開】あなたの研究シーズを芽吹かせる仕組みと花が開くまで	09:30 ~ 12:00 T15 ヘロスカイトの基礎科学から応用展開	13:30 ~ 16:30 T15 ヘロスカイトの基礎科学から応用展開	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:00 ~ 19:15 6.3 酸化物エレクトロニクス
	A308	118	09:00 ~ 11:30 2.5 放射線誘起蛍光体	13:30 ~ 16:30 2.5 放射線誘起蛍光体	09:30 ~ 11:30 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	13:00 ~ 19:00 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	09:15 ~ 12:00 CS.6 3.10 フォトリソグラフィ・現象、3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクスのコードシェアセッション	13:15 ~ 16:30 3.10 フォトリソグラフィ・現象 (旧3.11)
	A309	118	09:30 ~ 12:00 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:30 ~ 16:15 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	09:00 ~ 11:30 6.1 強誘電体薄膜	13:00 ~ 18:15 6.1 強誘電体薄膜	09:00 ~ 11:30 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12)	13:00 ~ 18:00 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12)
	A310	48		13:00 ~ 17:00 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics	09:00 ~ 11:45 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション	13:30 ~ 16:45 CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.4 イオンビーム一般のコードシェアセッション	09:00 ~ 11:30 CS.2 3.2 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	
	A311	39	10:30 ~ 11:30 1.2 教育	13:00 ~ 15:30 1.1 応用物理一般・学際領域	09:30 ~ 11:45 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:30 ~ 15:45 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	09:30 ~ 11:30 9.5 新機能材料・新物性	13:00 ~ 17:00 9.5 新機能材料・新物性
	A401	1738		13:30 ~ 17:30 NT1【一般公開】再起する日本の先端ロジック半導体	09:45 ~ 10:45 8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 11:00 ~ 11:45 8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演	13:30 ~ 18:05 T11 資源循環型社会実現に挑むプラズマ科学	09:30 ~ 12:00 T22 国内のマテリアル戦略とインフォマティクス応用	13:30 ~ 17:15 T22 国内のマテリアル戦略とインフォマティクス応用
	A501	43			09:00 ~ 11:15 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	13:00 ~ 16:15 7.2 電子ビーム応用	09:00 ~ 11:30 9.3 ナノエレクトロニクス	13:00 ~ 14:00 9.3 ナノエレクトロニクス
A601	93	09:00 ~ 11:30 7.1 X線技術	13:00 ~ 15:30 7.1 X線技術	09:00 ~ 11:30 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」と統合)	13:00 ~ 17:15 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」と統合)	09:00 ~ 11:30 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」と統合)	13:00 ~ 16:00 8.4 プラズマライフサイエンス	
A602	93	09:00 ~ 11:30 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:00 ~ 18:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	09:00 ~ 10:00 4.8 Optica Special Lecture 10:15 ~ 11:45 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:00 ~ 18:45 CS.7 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボン・二次元材料のコードシェアセッション	09:00 ~ 11:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	13:00 ~ 16:15 2.4 医用応用	
熊本市民会館	B101	695	10:15 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶
	B201	250	09:00 ~ 11:30 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 15:15 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥	10:30 ~ 12:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 16:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 11:30 8.4 プラズマライフサイエンス	13:30 ~ 17:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価
	B202	73	10:00 ~ 11:45 15.1バルク結晶成長	13:30 ~ 15:15 15.1バルク結晶成長	09:00 ~ 11:45 CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシートのコードシェアセッション	13:30 ~ 18:00 11.1 基礎物性	09:45 ~ 11:30 11.1 基礎物性	13:30 ~ 16:45 11.1 基礎物性
	B203	108	09:00 ~ 12:00 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)		09:00 ~ 11:45 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	13:30 ~ 16:30 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9)	09:00 ~ 12:00 CS.12 9.4 熱電変換、合同セッションMのコードシェアセッション	13:30 ~ 15:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション
	B204	70			09:00 ~ 11:30 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	13:30 ~ 16:15 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5)	09:00 ~ 11:00 CS.3 3.4 レーザー装置・材料、3.13 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	13:30 ~ 19:00 11.4 アナログ応用および関連技術
	B205	64		13:30 ~ 18:30 4.3 Lasers and laser materials processing	09:00 ~ 11:30 3.6 レーザープロセス (旧3.7)	13:30 ~ 17:30 3.6 レーザープロセス (旧3.7)	09:00 ~ 11:45 3.6 レーザープロセス (旧3.7)	13:30 ~ 15:45 3.6 レーザープロセス (旧3.7)

# 日程表 (会場別2)

会場名	収容人数	9月22日(金)		9月23日(土)		
		午前	午後	午前	午後	
熊本城ホール	A201	298	09:00 ~ 12:15 CS.8 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション	13:30 ~ 17:15 T13 磁性・スピンと超伝導が織りなす新物理現象とデバイス応用	09:00 ~ 12:00 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術	13:30 ~ 16:30 10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術
	A202	160	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 17:15 T2 地球温暖化対策技術における応用物理	09:00 ~ 12:00 17.3 層状物質	13:30 ~ 16:30 17.3 層状物質
	A301	240	09:40 ~ 12:00 T7【一般公開】メタバースの中核をなす応用物理 ~人とデータをつなぐ多様なインターフェース技術~	13:30 ~ 16:20 T7【一般公開】メタバースの中核をなす応用物理 ~人とデータをつなぐ多様なインターフェース技術~	09:00 ~ 11:30 8.1 プラズマ生成・診断	13:00 ~ 16:45 8.1 プラズマ生成・診断
	A302	240	09:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:00 ~ 17:00 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	09:00 ~ 11:30 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	13:00 ~ 16:45 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」
	A303	240	09:00 ~ 11:15 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:15 T10 表面・界面における電子・イオン移動に基づくエネルギー変換の最前線	09:00 ~ 12:30 13.3 絶縁膜技術	13:30 ~ 15:30 13.3 絶縁膜技術
	A304	240	09:00 ~ 11:30 6.4 薄膜新材料	13:00 ~ 14:30 6.4 薄膜新材料	09:30 ~ 11:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:30 ~ 16:25 T4 フォトニクスと放射線科学の融合分野の進展
	A305	71	09:00 ~ 12:00 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術	13:30 ~ 16:40 T3 放射線計測の信頼性を確保するための計測標準・規格	09:00 ~ 12:00 13.8 光物性・発光デバイス	13:30 ~ 17:00 13.8 光物性・発光デバイス
	A306	144	09:00 ~ 11:30 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:00 ~ 18:45 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	09:00 ~ 12:00 2.1 検出器デバイス開発	13:00 ~ 13:45 2.1 検出器デバイス開発 14:30 ~ 15:00 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶
	A307	118	09:30 ~ 11:45 6.6 プローブ顕微鏡	13:00 ~ 17:30 6.6 プローブ顕微鏡	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化エレクトロニクス	13:00 ~ 17:00 6.3 酸化エレクトロニクス
	A308	118	09:15 ~ 12:00 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)	13:15 ~ 18:00 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11)	09:15 ~ 12:00 CS.5 3.10 フォトニック構造・現象、3.12 半導体光デバイスのコードシェアセッション	13:00 ~ 16:15 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14)
	A309	118	09:00 ~ 11:30 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12)	13:00 ~ 18:00 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	09:00 ~ 11:15 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12)	13:15 ~ 16:00 CS.4 3.10 フォトニック構造・現象、3.11 ナノ領域光学・近接場光学のコードシェアセッション
	A310	48	09:00 ~ 10:45 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	13:00 ~ 15:15 3.11 ナノ領域光学・近接場光学 (旧3.12)	09:00 ~ 11:00 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics	13:00 ~ 14:30 4.7 Quantum Optics, Nonlinear Optics and Structured Optics
	A311	39	09:00 ~ 11:30 9.1 誘電材料・誘電体	13:00 ~ 15:45 9.1 誘電材料・誘電体	09:00 ~ 11:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 15:00 16.2 エナジーハーベスティング
	A401	1738	09:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:30 ~ 17:50 T20 グリーン・サステナブル半導体製造技術の体系的構築	09:00 ~ 11:15 12.4 有機EL・トランジスタ	
	A501	43	10:30 ~ 11:15 CS.10 6.5 表面物理・真空、7.5 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	13:00 ~ 17:30 6.5 表面物理・真空		
A601	93	09:00 ~ 11:30 3.9 光子物理・技術 (旧3.10)	13:00 ~ 17:45 CS.9 6.2 カーボン系薄膜、KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション	09:00 ~ 11:30 3.9 光子物理・技術 (旧3.10)	13:15 ~ 16:00 3.9 光子物理・技術 (旧3.10)	
A602	93	09:00 ~ 11:30 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	13:00 ~ 17:45 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8)	09:00 ~ 11:15 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	12:45 ~ 17:00 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	
熊本市民会館	B101	695	09:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:30 ~ 14:45 3.12 半導体光デバイス (旧3.13)
	B201	250	09:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:45 ~ 17:30 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	13:30 ~ 14:45 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価
	B202	73	09:00 ~ 11:30 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 17:45 1.6 超音波	09:30 ~ 12:00 1.5 計測技術・計測標準	13:30 ~ 15:00 1.5 計測技術・計測標準
	B203	108	09:00 ~ 12:00 9.4 熱電変換	13:30 ~ 14:30 9.4 熱電変換	09:00 ~ 12:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	13:30 ~ 17:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境
	B204	70	09:30 ~ 11:15 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	13:30 ~ 17:30 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	09:00 ~ 12:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)	13:30 ~ 17:00 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6)
	B205	64	09:00 ~ 12:00 12.1 作製・構造制御	13:30 ~ 19:00 12.1 作製・構造制御	09:00 ~ 12:00 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:30 ~ 14:45 13.2 探索的材料物性・基礎物性

# 日程表 (会場別3)

会場名	収容人数	9月19日(火)		9月20日(水)		9月21日(木)		9月22日(金)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
熊本県国際交流会館	C301	51			13:00 ~ 16:45 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	09:00 ~ 10:45 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	13:30 ~ 17:15 11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデバイス応用	10:00 ~ 11:00 4.6 Terahertz Photonics		
	C401	45		09:00 ~ 12:30 1.3 新技術・複合新領域	13:45 ~ 14:45 1.3 新技術・複合新領域			09:00 ~ 11:30 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:30 ~ 16:15 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	
	C402	81			13:30 ~ 18:00 6.2 カーボン系薄膜	09:00 ~ 10:45 CS.9 6.2 カーボン系薄膜, KS.1 固体量子センサ研究会のコードシェアセッション	13:30 ~ 18:00 6.2 カーボン系薄膜	09:00 ~ 11:45 3.1.2 半導体光デバイス (旧3.13)		
	C501	108	09:30 ~ 12:00 10.5 磁場応用	13:30 ~ 18:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 12:00 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	13:30 ~ 17:30 10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス	09:00 ~ 10:30 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 18:45 10.3 スピンデバイス・磁気メモリストレージ技術	09:30 ~ 11:45 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	13:30 ~ 17:00 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」
	C601	230		13:30 ~ 17:45 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	09:00 ~ 11:45 13.9 化合物太陽電池	13:30 ~ 18:00 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」		13:30 ~ 20:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	09:00 ~ 12:00 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池	13:30 ~ 19:45 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池
TKP熊本カンファレンスセンター	D901	78		09:00 ~ 12:00 CS.14 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション	13:30 ~ 16:00 16.3 シリコン系太陽電池	09:00 ~ 12:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 19:00 13.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 11:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:30 ~ 17:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	
	D902	112	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 17:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 11:45 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 18:15 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30 ~ 16:30 12.7 医用工学・バイオチップ
	D903	121	09:00 ~ 12:15 13.9 化合物太陽電池	13:45 ~ 18:00 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 12:00 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 18:15 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 11:45 CS.13 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池, 13.9 化合物太陽電池, 16.3 シリコン系太陽電池のコードシェアセッション	13:30 ~ 18:30 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 12:30 12.4 有機EL・トランジスタ	14:00 ~ 17:45 12.4 有機EL・トランジスタ
熊本ホール 1 棟 展示ホール	P01 ~ P23	ポスターセッション	[13:30-15:30] 17 ナノカーボン・二次元材料		[13:30-15:30] 2 放射線 9.1 透電材料・透電体 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 9.3 ナノエレクトロニクス 9.5 新機能材料・新物性 13.9 化合物太陽電池				[13:30-15:30] 8.2 フラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.4 フラズマライサイエンス 15.5 IV族結晶, IV-IV族結晶	
			[16:00-18:00] 7 ヒーム応用 12.4 有機EL・トランジスタ 12.5 有機・ハイブリッド太陽電池 16.3 シリコン系太陽電池 FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	[09:30-11:30] 6.2 カーボン系薄膜 6.3 酸化物エレクトロニクス 11 超伝導 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」	[16:00-18:00] 1 応用物理学一般 12.1 作製・構造制御 12.6 ナノバイオテクノロジー 12.7 医用工学・バイオチップ	[09:30-11:30] 4 JSAP-Optica Joint Symposia 2023 6.1 強誘電体薄膜 6.4 薄膜新材料 6.5 表面物理・真空 6.6 フロー・顕微鏡 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価 15.6 IV族系化合物 (SiC) 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	[16:00-18:00] 3.1 光学基礎・光学新領域 (旧3.2「材料・機器光学」統合) 3.2 情報フォトニクス・画像工学 (旧3.3) 3.3 生体・医用光学 (旧3.4) 3.4 レーザー装置・材料 (旧3.5) 3.5 超高速・高強度レーザー (旧3.6) 3.6 レーザープロセス (旧3.7) 3.7 光計測技術・機器 (旧3.8) 3.8 テラヘルツ全般 (旧3.9) 3.9 光量子物理・技術 (旧3.10) 3.10 フォトニック構造・現象 (旧3.11) 3.12 半導体光デバイス (旧3.13) 3.13 光制御デバイス・光ファイバー (旧3.14) 3.14 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス (旧3.15) 9.4 熱電変換	[09:30-11:30] 10 スピントロニクス・マグネティクス 12.2 評価・基礎物性 12.3 機能材料・萌芽的デバイス KS.1 固体量子センサ研究会	[16:00-18:00] 3.11 ナノ領域光科学・近接場光学 (旧3.12) 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 13.2 探索的材料物性・基礎物性 13.3 絶縁膜技術 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス 13.8 光物性・発光デバイス	

※最終日9月23日(土)は、ポスターセッション、熊本市国際交流会館(C)、TKP熊本カンファレンスセンター(D)でのセッションはございません。